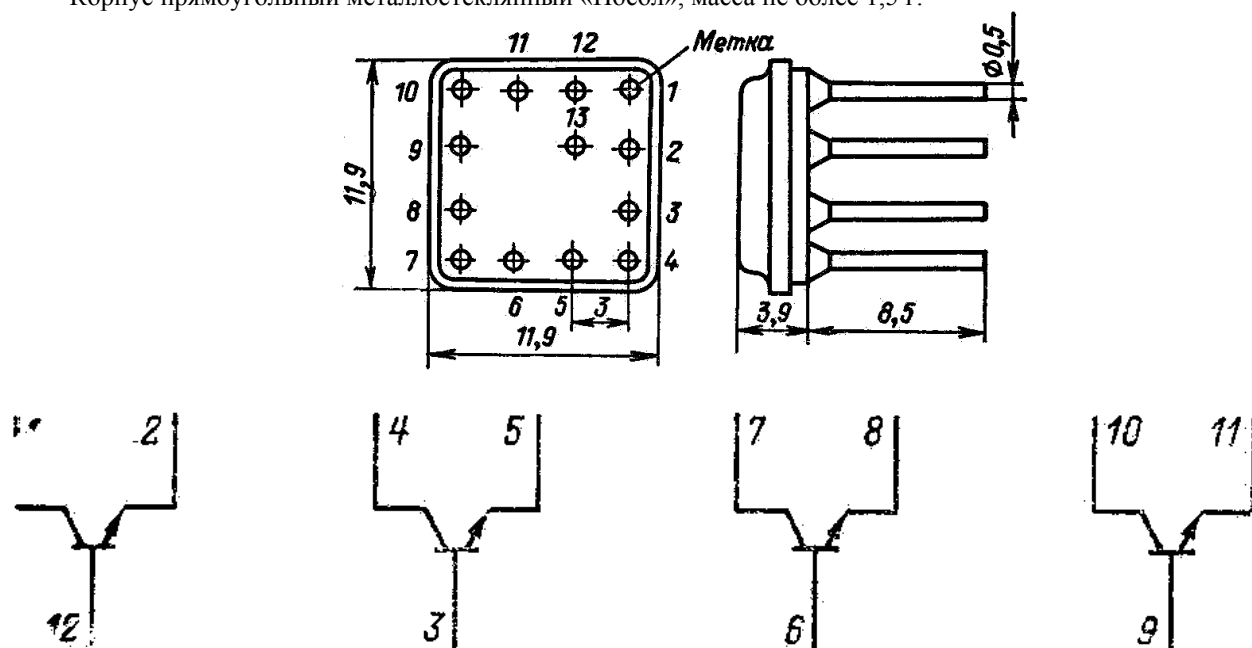


217НТ1 (2НТ171), 217НТ2 (2НТ172), 217НТ3 (2НТ173), К217НТ1 (К2НТ171), К217НТ2 (К2НТ172), К217НТ3 (К2НТ173)

Микросхемы представляют собой сборку из четырех n-p-n транзисторов.
Корпус прямоугольный металlostеклянный «Посол», масса не более 1,5 г.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	< 0,33 В
Обратный ток коллектора	< 1 мкА
Время рассасывания	< 25 нс
Коэффициент передачи по току	
(К)217НТ1	30...90
(К)217НТ2	50...150
(К)217НТ3	70...280

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор-эмиттер	10 В
Ток коллектора	20 мА
Рассеиваемая мощность одного транзистора	< 20 мВт
Температура окружающей среды	
217НТ1,2,3	-60...+70°C
К217НТ1,2,3	-30...+70°C
Многочисленное циклическое изменение температуры (217НТ1,2,3)	-60...+70°C
Относительная влажность воздуха при +40°C	до 98%
Атмосферное давление (217НТ1,2,3)	6,7x10 ² ...3x10 ⁵ Па
Вибрационные нагрузки	
217НТ1,2,3 (5-5000 Гц)	до 40 г
К217НТ1,2,3 (5-600 Гц)	до 5 г
Многочисленные удары с ускорением	
217НТ1,2,3	до 150 г
К217НТ1,2,3	до 15 г
Линейные нагрузки с ускорением	
217НТ1,2,3	до 150 г
К217НТ1,2,3	до 25 г
Одиночные удары с ускорением (217НТ1,2,3)	до 1000 г